

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 06-188169

(43)Date of publication of application : 08.07.1994

(51)Int.Cl.

H01L 21/027

G02B 27/28

G03F 7/20

G11B 5/127

G11B 5/91

(21)Application number : 05-212198

(71)Applicant : CANON INC

(22)Date of filing : 04.08.1993

(72)Inventor : UNNO YASUYUKI

(30)Priority

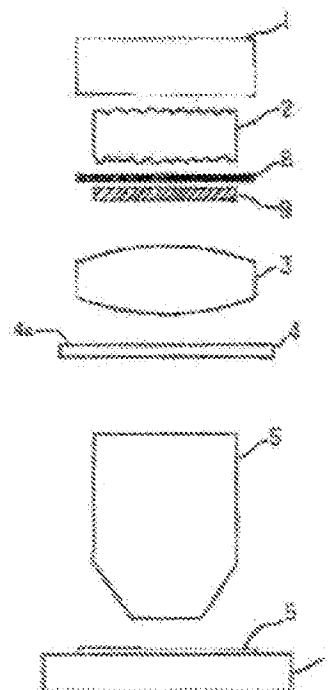
Priority number : 04247249 Priority date : 24.08.1992 Priority country : JP

(54) METHOD OF IMAGE FORMATION, EXPOSURE SYSTEM, AND MANUFACTURE OF DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide an image formation and an exposure system, in which a repetitive pattern is projected using most properly polarized light to obtain a high-resolution image.

CONSTITUTION: A repetitive pattern on a reticle 4 is illuminated by a lighting system. A beam of light diffracted from the pattern is admitted to the pupil of an optical projection system to project the pattern onto a wafer 6. A deflector 9 is used to select a projection beam that is linearly polarized in a plane perpendicular substantially to the direction in which the period of the pattern is minimized.



(19)日本国特許庁（ＪＰ）

(12) 公 開 特 許 公 報（Ａ）

(11)特許出願公開番号

特開平6－188169

(43)公開日 平成 6 年(1994) 7 月 8 日

(51)Int.Cl. ⁵	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
H 0 1 L 21/027				
G 0 2 B 27/28		A 9120－2K		
G 0 3 F 7/20	5 2 1	7316－2H		
G 1 1 B 5/127		D 7303－5D		
		7352－4M		
			H 0 1 L 21/ 30	3 1 1 L

審査請求 未請求 請求項の数46(全 16 頁) 最終頁に続く

(21)出願番号 特願平5－212198

(22)出願日 平成 5 年(1993) 8 月 4 日

(31)優先権主張番号 特願平4－247249

(32)優先日 平 4 (1992) 8 月 24 日

(33)優先権主張国 日本（ＪＰ）

(71)出願人 000001007

キャノン株式会社

東京都大田区下丸子 3 丁目30番 2 号

(72)発明者 畔野 靖行

東京都大田区下丸子 3 丁目30番 2 号

キャノン株式会社内

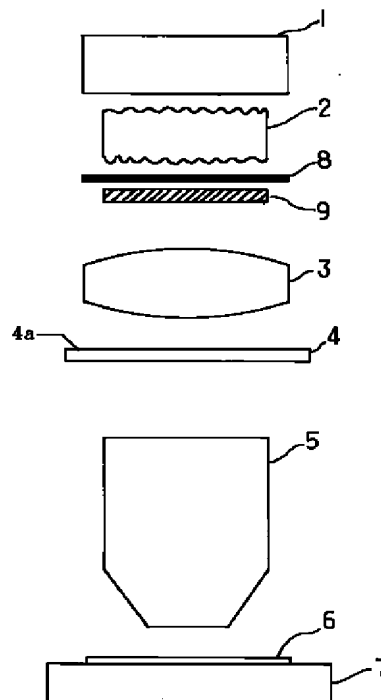
(74)代理人 弁理士 高梨 幸雄

(54)【発明の名称】 結像方法及び該方法を用いる露光装置及び該方法を用いるデバイス製造方法

(57)【要約】

【目的】 周期性のパターンを最適な偏光状態の光束を用いて高解像度で投影するようにした結像方法及び該方法を用いる露光装置を得ること。

【構成】 照明系からの光束でレチクル面上の周期性のあるパターンを照明し、該パターンから生じる回折光を投影光学系の瞳に入射させて、該パターンの像をウエハ面上に投影する際、偏光装置により該パターンの周期が最短となる方向に対して略直交する方向に偏光面を有する直線偏光の光束を選択して投影していること。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 ライン状のパターンを該パターンの長手方向に偏光した偏光ビームで結像していることを特徴とする結像方法。

【請求項2】 前記偏光ビームにより前記パターンを照明していることを特徴とする請求項1の結像方法。

【請求項3】 偏光していないビームにより前記パターンを照明し、前記パターンからのビームから前記偏光ビームを抽出していることを特徴とする請求項1の結像方法。

【請求項4】 前記パターンの結像が実質的に前記パターンからの2つの回折ビームにより行われていることを特徴とする請求項1、2又は3の結像方法。

【請求項5】 前記パターンに照明用のビームが斜入射していることを特徴とする請求項4の結像方法。

【請求項6】 前記パターンは位相シフターを備えていることを特徴とする請求項4の結像方法。

【請求項7】 ライン状のパターンを加工片上に前記ラインの長手方向に偏光した偏光ビームで結像し、該加工片上に前記パターンを転写してデバイスを製造していることを特徴とするデバイス製造方法。

【請求項8】 前記偏光ビームにより前記パターンを照明していることを特徴とする請求項7のデバイス製造方法。

【請求項9】 非偏光ビームにより前記パターンを照明し、前記パターンからのビームから前記偏光ビームを抽出していることを特徴とする請求項7のデバイス製造方法。

【請求項10】 前記パターンの結像が実質的に前記パターンからの2つの回折ビームにより行われていることを特徴とする請求項7のデバイス製造方法。

【請求項11】 前記パターンに照明用のビームが斜入射していることを特徴とする請求項10のデバイス製造方法。

【請求項12】 前記パターンは位相シフターを備えていることを特徴とする請求項10のデバイス製造方法。

【請求項13】 ライン状のパターンを照明手段により前記パターンの長手方向に偏光した偏光ビームで照明し、前記照明手段からの偏光ビームで照明された前記パターンを投影手段により基板上に投影し、露光するようにしたことを特徴とする露光装置。

【請求項14】 前記照明手段は前記パターンに前記偏光ビームを斜入射させていることを特徴とする請求項13の露光装置。

【請求項15】 ライン状のパターンを照明手段により非偏光ビームで照明し、前記照明手段からの非偏光ビームで照明された前記パターンを投影手段により前記パターンの長手方向に偏光した偏光ビームにより基板上に投影し、露光するようにしたことを特徴とする露光装置。

【請求項16】 前記照明手段は前記パターンに前記非

偏光ビームを斜入射させていることを特徴とする請求項15の露光装置。

【請求項17】 繰り返しパターンを繰り返しの周期が最も小さくなる方向と実質的に直交する方向に偏光した偏光ビームで結像していることを特徴とする結像方法。

【請求項18】 前記偏光ビームにより前記パターンを照明していることを特徴とする請求項17の結像方法。

【請求項19】 偏光していないビームにより前記パターンを照明し、前記パターンからのビームから前記偏光ビームを抽出していることを特徴とする請求項17の結像方法。

【請求項20】 前記パターンはラインとスペースより成るパターンを含んでいることを特徴とする請求項17の結像方法。

【請求項21】 前記パターンはドット状のパターンを含んでいることを特徴とする請求項17の結像方法。

【請求項22】 前記パターンの結像が実質的に前記パターンからの2つの回折ビームにより行われていることを特徴とする請求項17、18、19、20又は21の結像方法。

【請求項23】 前記パターンに照明用のビームが斜入射していることを特徴とする請求項22の結像方法。

【請求項24】 前記パターンは位相シフターを備えていることを特徴とする請求項22の結像方法。

【請求項25】 繰り返しパターンを加工片上に前記繰り返しの周期が最も小さくなる方向と実質的に直交する方向に偏光した偏光ビームで結像し、該加工片上に前記繰り返しパターンを転写し、デバイスを製造していることを特徴とするデバイス製造方法。

【請求項26】 前記偏光ビームにより前記パターンを照明していることを特徴とする請求項25のデバイス製造方法。

【請求項27】 非偏光ビームにより前記パターンを照明し、前記パターンからのビームから前記偏光ビームを抽出していることを特徴とする請求項25のデバイス製造方法。

【請求項28】 前記パターンはラインとスペースより成るパターンを含んでいることを特徴とする請求項25のデバイス製造方法。

【請求項29】 前記パターンはドット状のパターンを含んでいることを特徴とする請求項25のデバイス製造方法。

【請求項30】 前記パターンの結像が実質的に前記パターンからの2つの回折ビームにより行われていることを特徴とする請求項25、26、27、28又は29のデバイス製造方法。

【請求項31】 前記パターンに照明ビームが斜入射していることを特徴とする請求項30のデバイス製造方法。

【請求項32】 前記パターンは位相シフターを備えて

いることを特徴とする請求項30のデバイス製造方法。

【請求項33】 繰り返しパターンを照明手段により前記繰り返しパターンの周期が最も小さくなる方向と実質的に直交する方向に偏光した偏光ビームで照明し、前記照明手段からの偏光ビームで照明された前記パターンを投影手段により基板上に投影し、露光するようにしたことを特徴とする露光装置。

【請求項34】 前記照明手段は前記パターンに前記偏光ビームを斜入射させていることを特徴とする請求項33の露光装置。

【請求項35】 繰り返しパターンを照明手段により非偏光ビームで照明し、前記照明手段からの非偏光ビームで照明された前記パターンを投影手段により繰り返しパターンの周期が最も小さくなる方向と実質的に直交する方向に偏光した偏光ビームにより基板上に投影し、露光するようにしたことを特徴とする露光装置。

【請求項36】 前記照明手段は前記パターンに前記非偏光ビームを斜入射させていることを特徴とする請求項35の露光装置。

【請求項37】 周期性のあるパターンを該パターンの周期方向に対応した直線偏光の光束で照明し、該パターンを投影光学系により所定面上に投影するようにしたことを特徴とする像投影方法。

【請求項38】 周期性のあるパターンを該パターンの配列方向と直交する方向に偏光面を有する直線偏光の光束で照明し、該パターンから生じる回折光を投影光学系の瞳に入射させて、該パターンを所定面上に投影するようにしたことを特徴とする像投影方法。

【請求項39】 照明系からの光束を直線偏光の偏光方向を任意に変えて射出させることができる偏光装置を介して周期性のあるパターンをその周期が最短となる方向に対して略直交する方向に偏光面を有する光束で照明し、該パターンから生じる回折光を投影光学系の瞳に入射させて、該パターンを所定面上に投影するようにしたことを特徴とする像投影方法。

【請求項40】 照明系からの光束でレチクル面上の周期性のあるパターンを照明し、該パターンから生じる回折光を投影光学系の瞳に入射させて、該パターンの像をウエハー面上に投影する際、該パターンを該パターンの周期が最短となる方向に対して略直交する方向に偏光面を有する直線偏光の光束で照明していることを特徴とする露光装置。

【請求項41】 周期性のあるパターンを照明し、該パターンを投影光学系により所定面上に投影する際、該パターンの周期方向に対応した直線偏光の光束を用いて投影していることを特徴とする像投影方法。

【請求項42】 周期性のあるパターンを照明し、該パターンから生じる回折光を投影光学系の瞳に入射させて該パターンを所定面上に投影する際、該パターンの配列方向と直交する方向に偏光面を有する直線偏光の光束を

用いて投影していることを特徴とする像投影方法。

【請求項43】 照明系からの光束で周期性のあるパターンを照明し、該パターンから生じる回折光を投影光学系の瞳に入射させて該パターンを所定面上に投影する際、偏光装置により該パターンの周期が最短となる方向に対して略直交する方向に偏光面を有する光束を選択して該パターンの投影を行っていることを特徴とする像投影方法。

【請求項44】 照明系からの光束でレチクル面上の周期性のあるパターンを照明し、該パターンから生じる回折光を投影光学系の瞳に入射させて、該パターンの像をウエハー面上に投影する際、偏光装置により該パターンの周期が最短となる方向に対して略直交する方向に偏光面を有する直線偏光の光束を選択して投影していることを特徴とする露光装置。

【請求項45】 回路パターンを持った原版とウエハーとを用いる工程と、請求項37、38、39、41、42、43のいずれかの方法によって原版の回路パターンをウエハーに露光転写する工程を有することを特徴とする半導体素子製造方法。

【請求項46】 請求項45の製造方法によって製造されたことを特徴とする半導体素子。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は、結像方法及び該方法を用いる露光装置及び該方法を用いるデバイス製造方法に関する。

【0002】特に本発明は、ICやLSI、CCD、液晶パネル、磁気ヘッド等の各デバイスを製造する際に有用な結像方法及び該方法を用いる露光装置及び該方法を用いるデバイス製造方法に関する。

【0003】この他本発明は、半導体素子の製造装置であるステッパーにおいてレチクル又はマスク（以下「レチクル」と称する）面上の線幅の小さい電子回路パターン（パターン）を適切なる光束で照明し、ウエハー面上に高い解像力で投影することができる像投影方法及びそれを用いた露光装置に関するものである。

【0004】

【従来の技術】IC、LSI等の半導体チップの高集積化に対する要求が高まっているので紫外光により照明した回路パターンを縮小投影して転写を行う所謂ステッパー（縮小投影露光装置）の解像力の向上のために様々な改良がなされている。

【0005】従来、解像力を高める方法として、縮小投影レンズ系の開口数（NA）を大きくする方法、及び露光光の波長を短くする方法等が採られてきた。又、最近では、これらの方法とは別に位相シフト法や斜入射照明方法等、特に周期性のある微細パターン（繰り返し微細パターン）を結像するために有効な手法が提案されている。

【0006】周期性のある微細なパターンの結像について、以下に説明する。

【0007】図32は、3本の微細なスリットから成る繰り返しパターンを示すグラフであり、グラフの横軸にパターン位置 X を、縦軸に振幅透過率 T をとっている。図中、透過率1の部分は光が透過し、透過率0の部分は光が遮られる。

【0008】このような振幅透過率をもつ繰り返しパターンをコヒーレントな光で照明すると、入射光は0次、+1次、-1次、及び他の高次の回折光へと分かれる。このうち像の形成に寄与するのは投影光学系の瞳に入射する回折光のみであり、一般には0次、+1次、-1次の回折光が投影光学系の瞳に入射する。

【0009】図33は0次、 ± 1 次の回折光の瞳上における振幅を示す説明図である。図中100、101、102はそれぞれ0次、+1次、-1次の回折光のピーク位置を、 I_A は振幅を表す。

【0010】図34は0次、 ± 1 次の回折光により形成されるパターン像の強度分布を示している。縦軸は強度 I を示している。通常の結像では、パターンの線幅が非常に小さくなって0次の回折光しか投影光学系の瞳に入射なくなると、もはやパターンの像は形成されなくなってしまう。

【0011】これに対して位相シフト法では、光が上記繰り返しパターンを透過する際、隣合うスリットからの回折光の位相が180度ずれるようにパターンに細工をすることにより、投影光学系の瞳上で0次の回折光成分が現れないようにし、パターンの像を+1次と-1次の回折光によって形成している。

【0012】3本の微細スリットから成る繰り返しパターンを、位相シフト法を用いて投影した際に投影光学系の瞳上にできる振幅分布を図35に示す。図中103、104はそれぞれ+1次、-1次の回折光成分のピーク位置を表す。この場合パターンの繰り返し周期を同じとすればピーク位置103、104間の距離が図33の ± 1 次の回折光のピーク位置間の距離に比べて半分になる。位相シフト法を用いると、パターンの空間周波数を見掛け上小さくすることができるので、より微細なパターンからの ± 1 次の回折光が瞳上に入射する。従って、解像度が向上する。

【0013】図33の瞳上の振幅分布は、パターンが描かれた平面に対して垂直な方向から光を入射させた場合のものであるが、この平面に斜めから光を入射させることによって、瞳上に振幅分布の位置を横方向にずらすのが斜入射法である。

【0014】図36は瞳上に0次と+1次の回折光が入るように繰り返しパターンに光を斜入射させたときの瞳上の振幅分布を示す説明図である。図中105、106はそれぞれ0次、+1次の回折光のピーク位置を表す。

【0015】図36に示す2つの回折光によって像を形

成することを考えれば、斜入射法でも、位相シフト法の場合と同様に、より微細なパターンからの回折光が瞳上に到達でき、解像度が向上する。

【0016】

【発明が解決しようとする課題】前述した位相シフト法や斜入射照明法による解像度の向上の効果には周期性のパターンを照明する場合、光の偏光状態が大きくかわっていることが本発明者の行ったシュミレーションの結果から明らかになった。そのため、照明光の偏光状態をパターンに対して最適な状態にしないと、位相シフト法や斜入射照明法等を用いても大きな解像度の向上が得られないという問題点が生じてくる。

【0017】本発明の目的は、微細パターンを結像するのに好適な改良された結像方法及び該方法を用いる露光装置及び該方法を用いてデバイス製造する方法を提供することにある。

【0018】この他、本発明は周期性のあるパターンを投影光学系で所定面上に投影する際、投影に用いる光束の偏光状態をパターンの周期方向に対応させて適切に設定することにより、高い解像力を維持しつつ高いコントラストで投影することができる半導体素子の製造に好適な像投影方法及びそれをを用いた露光装置の提供を目的とする。更には高集積度の半導体素子の製造方法の提供を目的とする。

【0019】

【課題を解決するための手段】(1-1)本発明の第1の形態は、ライン状のパターンを結像する結像方法において、前記パターンの長手方向に偏光した偏光ビームで前記パターンを結像せしめることを特徴とする。

【0020】(1-2)本発明の第2の形態は、ライン状のパターンを加工片上に結像し、該加工片上に前記パターンを転写するデバイス製造方法において、前記パターンの長手方向に偏光した偏光ビームで前記パターンを結像せしめることを特徴とする。

【0021】(1-3)本発明の第3の形態は、ライン状のパターンで基板を露光する露光装置において、前記パターンの長手方向に偏光した偏光ビームにより前記パターンを照明する手段と前記照明手段により照明された前記パターンを前記基板上に投影する手段とを有することを特徴とする。

【0022】(1-4)本発明の第4の形態は、ライン状のパターンで基板を露光する露光装置において、前記パターンを非偏光ビームで照明する照明手段と前記照明手段により照明された前記パターンを前記パターンの長手方向に偏光した偏光ビームにより前記基板上に投影する投影手段とを有していることを特徴とする。

【0023】(1-5)本発明の第5の形態は、繰り返しパターンを結像する結像方法において、繰り返しの周期が最も小さくなる方向と実質的に直交する方向に偏光した偏光ビームで前記パターンを結像せしめることを特

徴とする。

【0024】(1-6)本発明の第6の形態は、繰り返しパターンを加工片上に結像し、該加工片上に前記繰り返しパターンを転写するデバイス製造方法において、繰り返しの周期が最も小さくなる方向と実質的に直交する方向に偏光した偏光ビームで前記パターンを結像していることを特徴としている。

【0025】(1-7)本発明の第7の形態は、繰り返しパターンで基板を露光する露光装置において、繰り返しの周期が最も小さくなる方向と実質的に直交する方向に偏光した偏光ビームにより前記パターンを照明する照明手段と前記照明手段により照明された前記パターンを前記基板上に投影する投影手段とを有することを特徴とする。

【0026】(1-8)本発明の第8の形態は、繰り返しパターンで基板を露光する露光装置において、前記パターンを非偏光ビームで照明する照明手段と前記照明手段により照明された前記パターンを繰り返しの周期が最も小さくなる方向と実質的に直交する方向に偏光した偏光ビームにより前記基板上に投影する手段とを有することを特徴とする。

【0027】(1-9)本発明において、偏光ビームでパターンを照明するときには、当該パターンが形成された基板上に偏光板(膜)を形成したり、偏光ビームを発生するレーザー等の光源を設けたり、この照明の為の光学系中に偏光板(膜)を設ける。

【0028】また、本発明において、非偏光ビームで照明されたパターンを偏光ビームで結像するときには、当該パターンが形成されたマスク等の基板上に偏光板(膜)を形成したり、この結像の為の光学系中に偏光板(膜)を設ける。

【0029】本発明の好ましい形態では、上記照明光学系又は結像光学系の偏光板(膜)の方位を変え得るよう当該偏光板(膜)を系の光軸の回りに回転できるように構成する。この構成により所望の方向に偏光した偏光ビームが形成できる。

【0030】本発明の別の好ましい形態では、上記照明光学系又は結像光学系中に1/2波長板(膜)を設け、当該1/2波長板(膜)の光学軸の方位を変え得るよう当該1/2波長板(膜)を系の光軸の回りに回転できるように構成する。この構成により所望の方向に偏光した偏光ビームが形成できる。

【0031】又、本発明において、基板上に相異なるパターンが形成されており、これらのパターンの長手方向が互いに異なっていたり、これらのパターンの繰り返しの周期が最も小さい方向(最小周期方向)が互いに異なっているときには、夫々のパターンの長手方向又は/及び最小周期方向に直交する方向、に対応した偏光ビームにより各パターンを結像する。

【0032】このような結像を同時に行うとき各パター

ン毎にそれらに対応した偏光板(膜)を設けた状態で非偏光ビームを供給したり、一つのパターン以外の他のパターンにそれ又はそれらに対応した偏光を生じさせる為の1/2波長板(膜)を設けた状態で前記一つのパターンに対応した偏光ビームを供給したりする。この偏光板(膜)や1/2波長板(膜)はパターンの光入射側又は光射出側の少なくとも一方に設けるとよい。

【0033】このような結像を順次行うとき、照明光学系又は結像光学系を前記の好ましい形態の如く構成し、各パターンに対応する偏光ビームを発生させる。

【0034】本発明の好ましい形態では前記パターンが照明ビームにより斜方向から照明されたり、前記パターンに位相シフターが供給されたりし、前記パターンからの実質的に2つの回折ビームにより結像が行われる。

【0035】(1-10)本発明の像投影方法は(1-10-イ)周期性のあるパターンを該パターンの周期方向に対応した直線偏光の光束で照明し、該パターンを投影光学系により所定面上に投影するようにしたことを特徴としている。

【0036】(1-10-ロ)周期性のあるパターンを該パターンの配列方向と直交する方向に偏光面を有する直線偏光の光束で照明し、該パターンから生じる回折光を投影光学系の瞳に入射させて、該パターンを所定面上に投影するようにしたことを特徴としている。

【0037】(1-10-ハ)照明系からの光束を直線偏光の偏光方向を任意に変えて射出させることができる偏光装置を介して周期性のあるパターンをその周期が最短となる方向に対して略直交する方向に偏光面を有する光束で照明し、該パターンから生じる回折光を投影光学系の瞳に入射させて、該パターンを所定面上に投影するようにしたことを特徴としている。

【0038】(1-10-ニ)周期性のあるパターンを照明し、該パターンを投影光学系により所定面上に投影する際、該パターンの周期方向に対応した直線偏光の光束を用いて投影していることを特徴としている。

【0039】(1-10-ホ)周期性のあるパターンを照明し、該パターンから生じる回折光を投影光学系の瞳に入射させて該パターンを所定面上に投影する際、該パターンの配列方向と直交する方向に偏光面を有する直線偏光の光束を用いて投影していることを特徴としている。

【0040】(1-10-ヘ)照明系からの光束で周期性のあるパターンを照明し、該パターンから生じる回折光を投影光学系の瞳に入射させて該パターンを所定面上に投影する際、偏光装置により該パターンの周期が最短となる方向に対して略直交する方向に偏光面を有する光束を選択して該パターンの投影を行っていることを特徴としている。

【0041】(1-11)又、本発明の露光装置としては

(1-11-イ) 照明系からの光束でレチクル面上の周期性のあるパターンを照明し、該パターンから生じる回折光を投影光学系の瞳に入射させて、該パターンの像をウエハー面上に投影する際、該パターンを該パターンの周期が最短となる方向に対して略直交する方向に偏光面を有する直線偏光の光束で照明していることを特徴としている。

【0042】(1-11-ロ) 照明系からの光束でレチクル面上の周期性のあるパターンを照明し、該パターンから生じる回折光を投影光学系の瞳に入射させて、該パターンの像をウエハー面上に投影する際、偏光装置により該パターンの周期が最短となる方向に対して略直交する方向に偏光面を有する直線偏光の光束を選択して投影していることを特徴としている。

【0043】

$$A(x, y) = \iiint F(U(x_1, y_1)) \exp\{ik(\alpha x + \beta y)\} d\alpha d\beta \quad \text{と書ける。}$$

式中 $F(U(x_1, y_1))$ はパターンの振幅透過率 $U(x_1, y_1)$ のフーリエ変換であり、このフーリエ変換を投影光学系の開口数で決まる瞳面の範囲内で再びフーリエ変換している。但し式中 (α, β) は瞳面上の座標であり、 $F(U(x_1, y_1))$ は (α, β) の関数になっている。

【0046】この式は照明光がコヒーレントな場合の式であるが、照明光が部分コヒーレントな場合にも、扱いは多少複雑になるが、基本的には同じである。

【0047】上に述べた式を用いたシュミレーションでは、投影光学系の開口数が小さい場合は正しい結果が得られるが、その開口数が大きくなるといくつかの問題が生じることが、本発明者の行った検討により、明らかになった。

【0048】上式の一の問題点は入射光の偏光状態が考慮されていないことである。このことを図を用いて説明する。説明には前述の3本のスリットより成る繰り返しパターンの例を用いる。

【0049】図26は図33で示した瞳上の振幅分布を、投影光学系のガウス像点110を基準とした参照球面111上に描いている。像面112上の点110における振幅は、投影光学系の波面収差を無視すれば参照球面111上の振幅の積分によって決まり、又、像面112上で点110から距離 x だけずれた点における振幅は、距離 x と参照球面111上の座標から決まる、ある位相差を考慮して参照球面111上の振幅を、積分することによって計算される。

【0050】ここから先は、話を簡単にするために、点110における振幅の計算に議論を限ることにする。

又、ここで座標軸の定義を行っておく。

【0051】図26に示すように光軸を z 軸とし、紙面内で z 軸に垂直な軸を x 軸、及び紙面に垂直な方向の軸を y 軸とする。上に述べたスカラー回折理論による考え

【実施例】まず本発明の各実施例を説明する前に、一般的な結像特性のシュミレーションに用いられる所謂スカラー回折理論と、本発明者がシュミレーションに用いた上記スカラー回折理論よりも精度の高い理論について説明する。

【0044】スカラー回折理論では、物体のパターンが照明されると、そのパターンのフーリエ変換像が投影光学系の入射瞳上に形成され、このフーリエ変換像を投影光学系の開口数(NA)の範囲内で再びフーリエ変換して、像面上にある振幅分布のパターン像が形成される。これを式で表現すると、像面上の点 (x, y) における振幅 $A(x, y)$ は

【0045】

【数1】

方では、点110における振幅は参照球面111上の振幅をそのまま足し合わせた形で計算される。

【0052】光には偏光というものがあり、例え完全にコヒーレントな光同士であっても、その偏光方向が異なっていると完全には干渉しないし、それが例えば直交していると干渉は全く起こらない。

【0053】繰り返しパターンを構成するスリットの長手方向が y 軸に平行で、繰り返しパターンが x 軸方向に周期を持つとして、 z 軸に平行な方向から光でスリットを照明すれば参照球面111上では図26の振幅分布が形成される。照明光が y 軸方向(スリットに平行な方向)に偏光した直線偏光であり、投影光学系内で偏光方向の変化が無視できるとすれば、上記の振幅分布の各点における偏光方向も、照明光と同様に全ての位置で y 軸方向となる。

【0054】スリットで回折された光のうち y 軸方向に偏光した光のみで参照球面111上の振幅分布が形成されているとすると、像面112上に達する光の偏光方向もすべて同一となる。この場合も、点110における振幅は参照球面111上の振幅をそのまま積分することによって求まる。

【0055】一方、照明光が x 軸方向(スリットに直交する方向)に偏光した直線偏光である場合は図27に示すように、参照球面111から点110に向けた代表的な光線120~124を考えた場合、偏光方向と光の進行方向は直交するという条件から、光線120~124の偏光方向はそれぞれ図中125~129の矢印のようになる。この場合の偏光は x, z 両偏光成分を持っており、点110における振幅はそれぞれの偏光成分毎に考える必要がある。点110における光の強度はそれぞれの偏光成分による振幅から得られる強度の合計となる。

【0056】次にこの考え方を適用してシュミレーショ

ンを行った結果について説明する。まず図33で説明した0次、+1次、-1次の回折光成分を用いる結像では、照明光の2つの偏光方向に対して、即ちスリットから回折される光のうちx軸方向とy軸方向のどちらの方向の偏光成分を用いるかによって得られる最終的な強度分布はそれぞれ図28、図29のようになる。

【0057】図28は照明光の偏光方向がスリットに平行な場合であり、像はy軸方向の偏光成分のみで形成される。一方、図29は照明光の偏光方向がスリットに垂直な場合であり、像はx偏光成分及びz偏光成分の合計として形成される。

【0058】同様のシュミレーションによって、位相シフト法や斜入射照明法のように、0次、+1次、-1次の3つの回折光のうちの2つの回折光を用いる結像を評価したものを、次に示す。

【0059】像面上の強度分布の結果のみを示すと、照明光の偏光方向がy軸方向（スリットに平行）の場合は図30に示す強度分布に、偏光方向がx軸方向（スリットに垂直）の場合は図31に示す強度分布になる。

【0060】ここでは、偏光方向がスリットに垂直な場合はz方向の偏光成分の影響で、偏光方向がスリットに平行な場合に比べて、像のコントラストがかなり悪い。通常の露光では照明光は無偏光の状態になっているので、強度分布は図30、図31の強度分布を平均したものになるが、その場合でも図31の強度分布に比べてコントラストが劣化する。

【0061】このように、照明光の偏光方向が結像特性に大きな影響を与えることが本発明者の行った精度の高いシュミレーションの結果から明らかになった。

【0062】特に、解像度を高めるために位相シフト法、又は斜入射照明法を適用した場合に、投影する周期性のあるパターンに対して照明光の偏光方向を適切に制御することにより、期待以上の解像度が得られる。

【0063】以上が本発明が行った結像特性に関するシュミレーションの結果である。

【0064】次に本発明の各実施例について説明する。

【0065】図1は本発明の像投影方法を半導体素子やCCDや液晶パネルや磁気ヘッド等のデバイス製造用のステッパー（ステップ&リピート型投影露光装置）に適用したときの実施例1の要部概略図である。

【0066】図中、1は超高圧水銀灯等の光源である。光源1から出た光はオプティカルインテグレーター2によって光量分布が均一化された、アパーチャー8と偏光装置9を介して照明レンズ3によりレチクル4面上のパターン（回路パターン）4aを照明する。レチクル4のパターン4aで回折された光は、投影レンズ5に入射し、投影レンズ5を介してステージ7の上に載った半導体ウエハー6上にパターン4aの像を形成している。

【0067】ここでオプティカルインテグレーター2から射出した光は、その全ての光束が照明レンズ3に到達

するのではなく、オプティカルインテグレーター2に接近して置かれた開口絞りである所のアパーチャー8によって照明に適した部分のみが選択され、選択された光は偏光装置9を透過する際、その偏光状態が円又は楕円偏光又は非偏光の状態から直線偏光に変換される。偏光装置9は、直線偏光の偏光方向をパターン4aの繰り返しの方向等の条件に応じて変えることができる。

【0068】レチクル4には、樽体ウエハー6上への転写を行うための線幅の小さい回路パターン4aが描かれており、照明レンズ3を介してレチクル4に入射する照明光は上記回路パターン4aに応じてレチクル4を透過する。半導体ウエハー6上にはレジスト等の感光材料が塗布されており、そこに回路パターン4aの像を転写することが可能になっている。

【0069】投影レンズ5はレチクル4上の回路パターン4aの像を半導体ウエハー6上に所定の倍率に縮小（一般に1/5又は1/10）して投影している。その際、レチクル4と半導体ウエハー6は、ステージ7を駆動することによって所定の位置関係に調整される。半導体ウエハー6上のあるショットへの露光が終了すると、半導体ウエハー6はステージ7によって水平方向に所定量移動され、そこで、半導体ウエハー6上の他ショットの露光を行うことを繰り返す。

【0070】本実施例ではレチクル4上の回路パターン4aとして図2に示すy方向に延びるスリットを5本x方向に並べた、x方向に周期性を有する繰り返しパターンを用いている。図中10～14が開口で、この開口10～4の周囲は遮光部より成り、光はこの部分のみを透過する。又、一点鎖線15はスリット状の開口10～14の繰り返し方向（x方向）に引いた基準線であり、後の説明で用いる。

【0071】ここでは、主光線がレチクル4に対して鉛直な方向から傾いた光束でレチクル4を照明することにより像のコントラストを向上させる。

【0072】図3は図2のパターン4aの一点鎖線15に沿った断面図である。斜入射照明法により光束20、21を傾ける方向としては、図3に示すようにパターン4aが繰り返しているZX平面内で光束の主光線が斜めになるようにする。この条件を満たすべく、本実施例ではアパーチャー8の開口を図4に示すよう構成している。尚、x軸はパターン4aの繰り返しの周期が最も小さくなる方向に向いている。

【0073】図4において斜線部分22は光が通らないように遮光されている遮光領域である。2つの円形開口23、24は光透過領域であり、この領域23、24からの光がパターン4aの結像に寄与する。図中、25は円形開口23、24の中心を通るように引いた基準線である。

【0074】図1のアパーチャー8で選択された照明光は次に、偏光装置9に入射する。偏光装置9は図5に示

すように、偏光装置9の上面から入射する光の偏光成分のうち、図中矢印26で示したy方向の偏光光のみを透過させ、他の方向の偏光光は遮るような構造になっている。図中一点鎖線27は上記矢印26に直交する方向に引いた基準線である。図1のレチクル4、アパーチャー8、そして偏光装置9の水平面内での配置は、図2、4、5中にそれぞれ示した基準線15、25、27がお互いに平行になるように設定している。

【0075】以上のような構成により、斜入射照明光の偏光方向をパターン4aのスリット方向に平行なy方向になるようにして、即ちパターン4aの繰り返しの周期が最小となるx方向に直交するようにして、パターン4aの結像と焼付けを行うことにより、図30で説明したように高解像度で、かつコントラストの高い像を半導体ウエハー6上に得ている。レチクル4上のパターンとしてドット上の繰り返しパターンの場合も、同様の効果がある。

【0076】次に本実施例において、レチクル4上のパターン4aが、図2のように1方向に周期性のある単一パターンのみでなく、図6に示すように各々が縦、横の(y, x)の2方向に周期性のある2つのパターンを持っている場合について説明する。

【0077】この場合、図6の破線30で囲まれた部分の繰り返しパターンは上述の方法を用いることにより、良好に投影転写を行うことができる。しかしながら破線31で囲まれた部分の繰り返しパターンについては照明光の偏光方向がスリットに直交する方向になるので同じような効果は得られない。

【0078】そこで本実施例では、図6のレチクルを図7と図8に示す2枚のレチクルに分割し、別々に露光している。即ち図7のパターンについては前述した通り、y方向に偏光した直線偏光光で焼付けを行い、図8のパターンについては、パターンが繰り返す平面内で照明光がレチクルに斜入射し、かつ照明光の偏光方向がスリットの長手方向に平行な方向となるように、即ちx方向に偏光した直線偏光光となるように、不図示の駆動装置によりアパーチャー8と偏光装置9を水平面内で光軸を中心に90度回転させてから固定してから焼付けを行っている。この方法はスリットのパターンが縦、横の2方向に限らず、他の方向になった場合も同様に適用可能である。

【0079】又、図6に示すように一つのレチクルに2種類の繰り返しパターンがある場合、レチクルと共役な場所に設けたマスキングブレードを用いて各パターンを順次照明するようにし、上記方法で各パターンを偏光光で照明する。

【0080】本実施例ではレチクル上のパターンは5本のライン&スペースで形成されているとして説明を行ったが、5本以外のライン&スペースパターンについても同様に適用可能である。又、ライン&スペースの幅の比

は1対1に限られるものではなく、更にパターンの周期がある程度不規則になった場合でも本発明は同様に適用可能である。

【0081】又、本実施例において偏光装置9を照明レンズ3とレチクル4との間又はレチクル4と投影レンズ5との間又は投影レンズ5の内部(瞳面上)に配置しても良い。

【0082】偏光装置9をレチクル4と投影レンズ5との間に配置したときは、偏光装置9によってレチクル4上のパターン形状に応じてパターン4aで回折された回折光のうち、特定の方向に偏光した偏光光が選択され、この選択された偏光光束のみが投影レンズ5に入射するようになる。そしてこの偏光光束でパターン4aの像をウエハー6上に投影する。

【0083】次に本発明の実施例2について説明する。実施例2の装置構成は図1の実施例1と略同じである。実施例2が実施例1と異なる点はレチクル4上のパターンに位相シフト法を適用していることである。

【0084】図9は本実施例のレチクル4上のパターン4aの説明図である。同図に示すようにパターン4aが5本のy方向に延びるスリット状の開口40~44から成っている点は図1の実施例1と同じであるが、図9のパターンは斜線部分40、42、44に透過する光の位相を部分41、43を透過する光に対して180度変化させる位相シフターが設けられている点に特徴がある。

【0085】又、本実施例ではアパーチャー8の形状としては図10に示すように斜線部分45の遮光部で囲まれた中心の円形部分46の開口からの光のみが透過できるものを用いている。

【0086】本実施例では、パターン4aとアパーチャー8を用いて実施例1と同様の偏光装置9を組み合わせ、図9中のパターン4aに対して、照明光の偏光方向がスリットの長手方向に平行な方向(y方向)となるようにしている。これによって位相シフト法を用いて良好なパターンの焼付けを行っている。

【0087】又、レチクル4上のパターン4aが図9のように1種類でなく、図6のように異なる方向に繰り返しが生じている複数種の場合でも、実施例1と同様に同じ向きのパターン毎にレチクルを複数枚用いたりマスキングブレードを用いて分割して焼付けを行うことにより、対処できる。

【0088】次に本発明の実施例3について説明する。実施例3の装置構成も図1の実施例1と略同じである。

【0089】本実施例ではレチクル4上のパターン4aとして、図11に示すものを用いる。図11中、4はレチクルであり、座標系を前記各実施例と同じくxy面をレチクル4と平行、z軸をレチクル4に垂直になるように定めておく。図11中、210~214はパターンAのスリット状開口部であり、開口部210~214は矢印215で示すx方向に繰り返しパターンを構成してい

る。

【0090】同様に220～224はパターンBのスリット状開口部であり、開口部220～224は矢印225で示すy方向に繰返しパターンを構成している。パターンA、パターンBの夫々に位相シフト法が適用されている。位相シフト法を適用したパターンA、Bの詳細を図12を用いて説明する。

【0091】図12は図11に示したパターンAについて矢印215に沿った断面を描いたものである。図12中、230は透明なガラス基板であり、斜線部231はクロムより成る遮光部である。遮光部231と開口部210～214により周期パターンAが形成されている。位相シフト法は、開口部を透過する光の位相を隣り合う開口部の間で180度ずつ変化させることにより、結像系の解像度を向上させるものであり、図12中の32～34がそこを透過する光の位相を180度変化させる位相シフターを示している。

【0092】周期パターンBに関しても矢印225に沿った断面図は図12と同様になる。位相シフト法を適用したパターンの結像には、レチクル4に垂直な方向(z方向)から照明を行えば良いので、アパーチャー8としては図13に示すように、周辺の斜線部240が遮光部、中心の241が開口となっているものを用いる。

【0093】本実施例では偏光装置9として図14に示すものを適用する。偏光装置9は、そこに入射する光のうち図14中、両矢印50で示したy方向の偏光光のみを透過させるように構成されている。即ち、本実施例におけるステッパーの照明光は、偏光装置9を透過した後はy軸方向に偏光面を有する直線偏光光となる。

【0094】以上の構成でレチクル4上のパターン4aを照明すると、パターンA、Bと照明光の偏光方向の関係は図15及び図16に示すようになる。即ち、パターンAに対しては、図15に示すように偏光方向60はパターンを構成するスリットの長手方向と平行になり、これは前述の通り解像度が向上する条件を満たす。

【0095】一方パターンBに対しては図16に示すように偏光方向61はパターンを構成するスリットの長手方向に垂直になっており、このままではパターンBに対してはパターンAほどの解像度の改善はできない。

【0096】そこで本実施例ではパターンBに入射する直線偏光光束の偏光面を90度回転させて、パターンBのスリットに平行な方向の直線偏光光束でパターンBを照明できるようにしている。

【0097】図17は図11と同様、パターンA、パターンBを示した、レチクル4の平面図であるが、図17のレチクル4はパターンBの直前に入射する直線偏光光束の偏光面を90度回転させる偏光変換装置70を偏光している点が特徴である。偏光変換装置70としては、例えば1/2波長板を適用できる。1/2波長板を適用した際の偏光面回転の様子を図24を用いて説明する。

【0098】図18中、矢印80の方向に進み両矢印81の方向(y方向)に偏光した直線偏光光束に対して偏光変換装置(ここでは1/2波長板)の光学軸82の方向をx軸と45度の角度をなすように配置すると、偏光変換装置70を透過した後の光束は、矢印83の方向に進み、両矢印84で示すようにx軸方向に偏光した直線偏光光束に変換される。

【0099】偏光変換装置70をパターンBの直前に配置することにより、パターンBと照明光束の偏光方向の関係は図19に示すようになる。即ち、両矢印90が示す偏光の方向がパターンBを構成するスリットと平行な関係になるため、パターンBに対してもパターンAと同様の解像度の向上が実現できることになる。

【0100】偏光変換装置70として旋光性を持った光学物質を適用すれば、直線偏光光束の偏光面の回転の大きさは偏光変換装置70の厚みによって制御することが可能になり、その場合には厚みの制御により直線偏光光束の偏光面の回転角度が90度以外の様な値に設定できるため、様々な方向の繰返しパターンに対して解像度の向上が可能となる。

【0101】本実施例では照明を行うパターンには位相シフト法が適用されているとして説明を行ったが、斜入射照明法を用いた場合でも適用することができるのは言うまでもない。

【0102】以上の各実施例において偏光装置9をレチクル1の表面又は裏面上に形成する変形例がある。

【0103】図20は本発明の像投影方法を半導体素子の製造用のステッパーに適用したときの実施例4の要部概略図である。図中、図1で示した要素と同一要素には同符号を付している。

【0104】図20において、光源1、オプティカルインテグレーター2、照明レンズ3、レチクル4、投影レンズ5、半導体ウエハー6、ステージ7等はそれぞれ図1のものと同様であるのでここでは省略する。

【0105】実施例4が実施例1～3と異なる点は、偏光装置の設置されている光路中の位置である。本実施例では偏光装置59をレチクル54の直前(照明レンズ3とレチクル54の間)に配置し、レチクル54に入射する光の偏光状態をレチクル54の直前で制御する構成になっている。

【0106】ここで、本実施例のレチクル54上のパターン54aは図21に示すように縦方向(y方向)に延びるスリット60～64より成る繰返しパターンと横方向(x方向)に延びるスリット65～69より成る繰返しパターンとからなっている。このように、縦横方向のパターンに対して斜入射照明で解像度を向上させるには、アパーチャー8の開口を図22のようにすれば良い。

【0107】図22中の斜線部70は遮光部で4隅に設けた円形開口部71～74が光透過部となっており、こ

の開口71〜74からの光をレチクル4に斜め入射させる。

【0108】本実施例ではこのような斜入射照明法に対して、パターン54aに入射する光の偏光方向がスリットの長手方向に対して常に平行になるように、偏光装置59を配置したものである。

【0109】図21中の59a、59bは入射した光のうちある一つの方向に偏光した直線偏光光のみを透過させる偏光部材であり、偏光部材59aは入射した光のうちスリット60〜64の長手方向に平行な方向(y方向)、に偏光した偏光光のみを透過するように設置されている。

【0110】一方、偏光部材59bはスリット65〜69の長手方向に平行な方向(x方向)に偏光した偏光光のみを透過させるように配置されている。偏光装置59としては、薄膜状の偏光板をその偏光軸方向を対応するパターンに合わせて決めてレチクル54上に貼りつけたもの等が適用可能である。

【0111】本実施例では、レチクル54上のパターン54aとして縦横2方向に延びるスリットを持つものについて説明したが、それ以外の方向に延びるスリットを持つパターンに対しても同様に適用可能である。

【0112】尚、本実施例において偏光装置9をレチクル54の直後(レチクル54と投影レンズ55との間)に配置しても良い。

【0113】このとき偏光装置9はレチクル54上に種々の方向に延びるスリットがあってもスリットから回折された光のうち、それぞれの方向のスリット毎に独立にスリットの長手方向に偏光した偏光光を選択できるようにし、そして、この偏光光で結像するようにしている。

【0114】次に本実施例の実施例5について説明する。実施例5の装置構成は図1の実施例1と略同じである。実施例5が実施例4と異なるのはレチクル4上のパターンに位相シフト法を適用していることである。

【0115】図23は本実施例のレチクル54面上のパターン54aの説明図である。同図に示すレチクル54上のパターンは縦方向(y方向)に延びるスリット80〜84、及び横方向(x方向)に延びるスリット85〜89から構成されている点では図21のパターンと同様であるが、本実施例では図中のスリットで斜線が施されている部分80、82、84、85、87、89に透過する光の位相を部分81、83、86、88を透過する光に対して180度変化させる位相シフト部材を設けている点が異なっている。

【0116】59a、59bは偏光部材であり、レチクル54に円もしくは楕円に偏光した光もしくは非偏光光が入射したときに、その光のうちスリットの長手方向に偏光した偏光光のみをスリットに入射させている。又、アパーチャー8としては実施例2の場合と同様図13に示したものをを用いている。

【0117】本実施例では以上のような構成によって、位相シフト法によって解像度の向上を図り、かつレチクル54上に縦横方向のパターンがある場合でも、各パターンに適した偏光光で半導体ウエハー6上に結像している。

【0118】ここではレチクル54上のパターンとして縦横2方向に延びるスリットを持つもので説明したが、それ以外の方向に延びるスリットを持つパターンに対しても同様に適用可能である。

【0119】ここではレチクル上のパターンが5本のライン&スペースで形成されている場合を例にとり示したが、5本以外のライン&スペースパターンについても同様に適用可能である。又、ライン&スペースの幅の比は1対1に限られるものではなく、更にパターンの周期性がある程度不規則になった場合でも同様に適用可能である。

【0120】又、ランプと偏光装置を用いず、直線偏光光を発するレーザーを露光用の光源としても良い。又偏光装置を用いるときやレーザーを用いるときに1/2波長板を光路に入れ、これを回転させて所望の偏光光を作るようにしても良い。

【0121】次に上記説明した露光装置を利用したデバイス製造方法の実施例を説明する。図24は半導体素子(ICやLSI等の半導体チップ、あるいは液晶パネルやCCD等)の製造のフローを示す。

【0122】ステップ1(回路設計)では半導体素子の回路設計を行なう。ステップ2(マスク製作)では設計した回路パターンを形成したマスクを製作する。

【0123】一方、ステップ3(ウエハー製造)ではシリコン等の材料を用いてウエハーを製造する。ステップ4(ウエハープロセス)は前工程と呼ばれ、上記用意したマスクとウエハーを用いてリソグラフィ技術によってウエハー上に実施例の回路を形成する。

【0124】次のステップ5(組み立て)は後工程と呼ばれ、ステップ4によって作成されたウエハーを用いて半導体チップ化する工程であり、アセンブリ工程(ダイシング、ボンディング)、パッケージング工程(チップ封入)等の工程を含む。ステップ6(検査)ではステップ5で作製された半導体素子の動作確認テスト、耐久性テスト等の検査を行なう。こうした工程を経て半導体素子が完成し、これが出荷(ステップ7)される。

【0125】図25は上記ウエハープロセスの詳細なフローを示す。

【0126】ステップ11(酸化)ではウエハーの表面を酸化させる。ステップ12(CVD)ではウエハー表面に絶縁膜を形成する。ステップ13(電極形成)ではウエハー上に電極を蒸着によって形成する。ステップ14(イオン打込)ではウエハーにイオンを打ち込む。ステップ15(レジスト処理)ではウエハーに感光剤を塗布する。ステップ16(露光)では上記説明した露光装

置によってマスクの回路パターンをウエハーに焼付け露光する。ステップ 1 7 (現像) では露光したウエハーを現像する。ステップ 1 8 (エッチング) では現像したレジスト像以外の部分を削り取る。ステップ 1 9 (レジスト剥離) ではエッチングが済んで不要となったレジストを取り除く。これらのステップを繰り返すことにより、ウエハー上に多重に回路パターンが形成される。

【0127】本実施例の製造方法を用いれば、従来は製造が難しかった高集積度の半導体素子を製造することができる。

【0128】

【発明の効果】本発明によれば以上のように各要素を設定することにより、微細パターンを結像するのに好適な、改良された結像方法及び該方法を用いる露光装置及び該方法を用いてデバイスを製造する方法を達成することができる。

【0129】この他本発明によれば以上のように周期性のあるパターンを投影光学系で所定面上に投影する際、投影に用いる光束の偏光状態をパターンの周期方向に対応させて適切に設定することにより、高い解像力を維持しつつ高コントラストで投影することができる半導体素子の製造に好適な像投影方法及び露光装置、更には製造方法を達成することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 本発明の像投影方法をステッパに適用したときの実施例 1 の要部概略図

【図 2】 図 1 のレチクルの説明図

【図 3】 図 1 のレチクルに対する照明光の様子を示す説明図

【図 4】 図 1 のアパーチャーの説明図

【図 5】 図 1 の偏光装置の説明図

【図 6】 図 1 のレチクルの他の実施例の説明図

【図 7】 図 6 の一部分の説明図

【図 8】 図 6 の一部分の説明図

【図 9】 本発明の実施例 2 にかかるレチクルの説明図

【図 1 0】 本発明の実施例 2 にかかるアパーチャーの説明図

【図 1 1】 レチクル上のパターンを表す図

【図 1 2】 図 1 1 のレチクル上のパターンの断面を表す図

【図 1 3】 本発明の実施例 3 に係るアパーチャーを表す図

【図 1 4】 本発明の実施例 3 に係る偏光装置を表す図

【図 1 5】 図 1 1 のパターンと照明光の偏光の関係を表す図

【図 1 6】 図 1 1 のパターンと照明光の偏光の関係を

表す図

【図 1 7】 本発明の実施例 3 に係るレチクル上のパターンを表す図

【図 1 8】 本発明の実施例 3 に係る偏光変換装置の働きを表す図

【図 1 9】 図 1 7 のパターンと照明光の偏光の関係を表す図

【図 2 0】 本発明の像投影方法をステッパに適用したときの実施例 4 の要部概略図

【図 2 1】 図 1 1 の一部分の説明図

【図 2 2】 図 1 1 の一部分の説明図

【図 2 3】 本発明の実施例 5 に係るレチクルの説明図

【図 2 4】 本発明に係る半導体素子の製造方法のフローチャート図

【図 2 5】 本発明に係る半導体素子の製造方法におけるウエハープロセスのフローチャート図

【図 2 6】 瞳上の振幅分布を表す説明図

【図 2 7】 光線の角度による偏光方向の違いを説明するための説明図

【図 2 8】 スリットに平行な方向に偏光した光を用いたときの像面上の強度分布を表す説明図

【図 2 9】 スリットに垂直な方向に偏光した光を用いたときの像面上の強度分布を表す説明図

【図 3 0】 スリットに平行な方向に偏光した光を用いたときの位相シフト法、斜入射照明による像面上の強度分布の説明図

【図 3 1】 スリットに垂直な方向に偏光した光を用いたときの位相シフト法、斜入射照明による像面上の強度分布の説明図

【図 3 2】 繰り返しパターンの振幅透過率を表す説明図

【図 3 3】 瞳上の振幅分布を表す説明図

【図 3 4】 像面上の強度分布を表す説明図

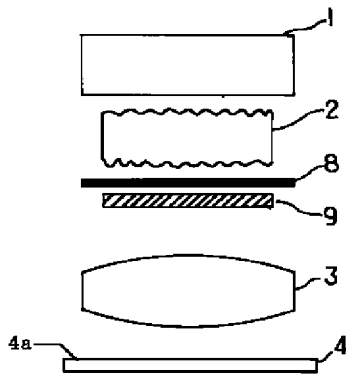
【図 3 5】 位相シフト法を用いた場合の瞳上の振幅分布を表す説明図

【図 3 6】 斜入射照明を用いた場合の瞳上の振幅分布を表す説明図

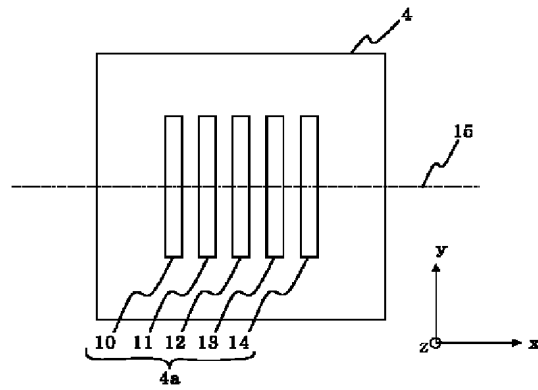
【符号の説明】

- 1 光源
- 2 オプティカルインテグレーター
- 3 照明レンズ
- 4 レチクル
- 5 投影レンズ
- 6 半導体ウエハー
- 7 ステージ
- 8 アパーチャー
- 9 偏光装置

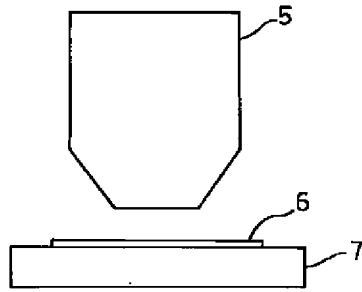
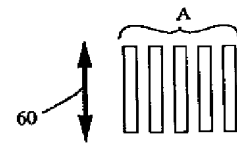
【図1】



【図2】

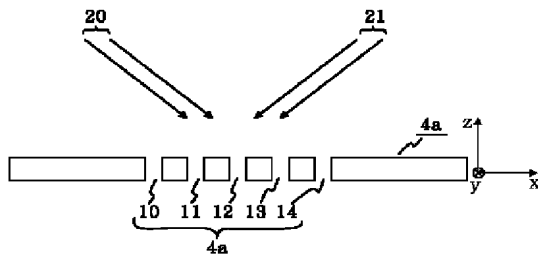
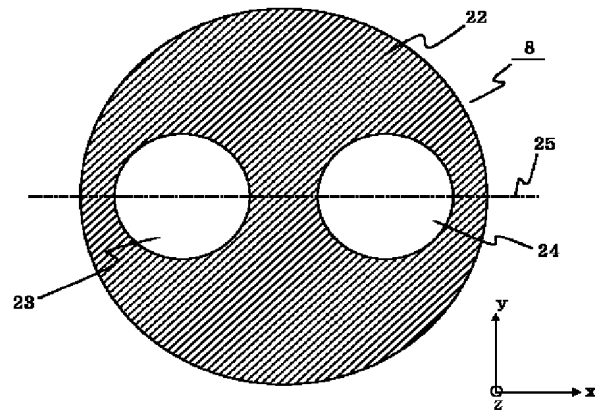


【図15】



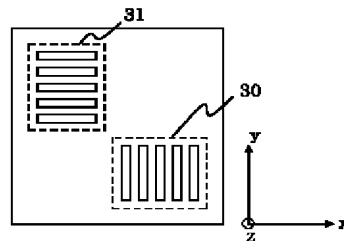
【図3】

【図4】

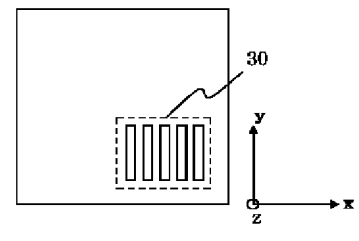


【図5】

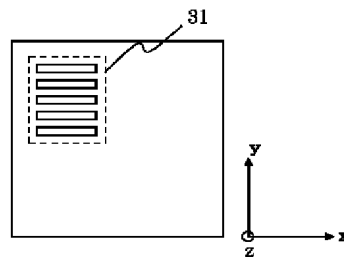
【図6】



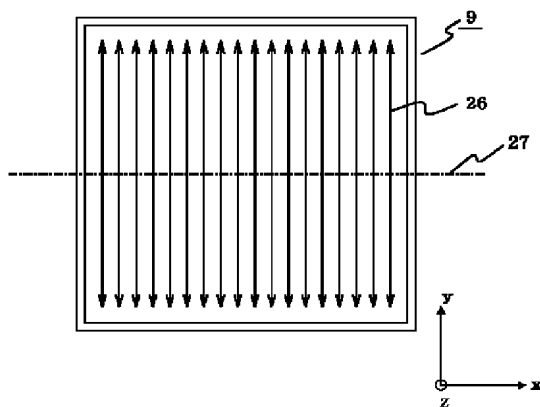
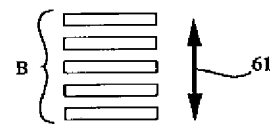
【図7】



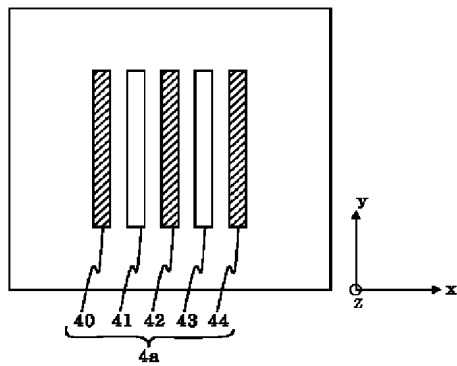
【図8】



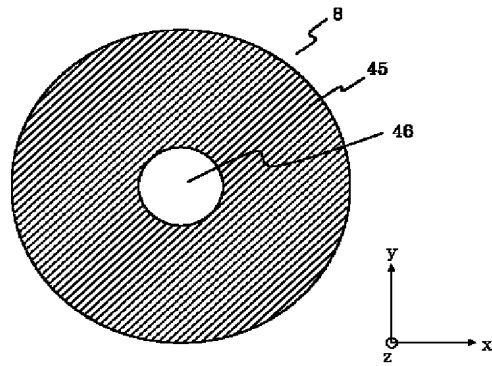
【図16】



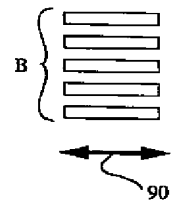
【図9】



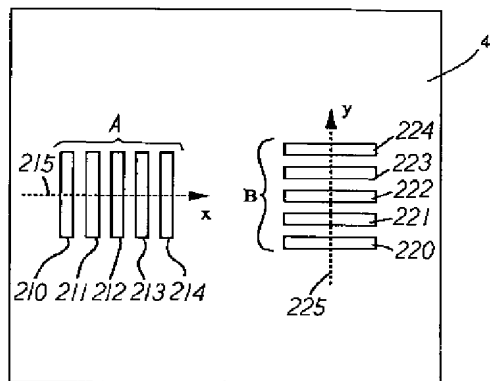
【図10】



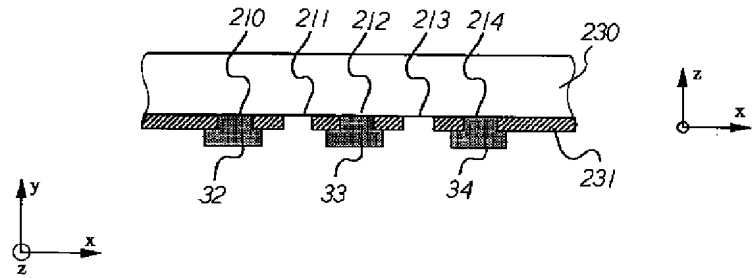
【図19】



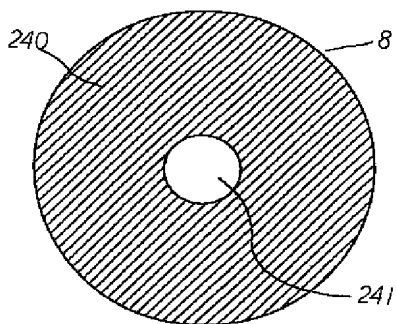
【図11】



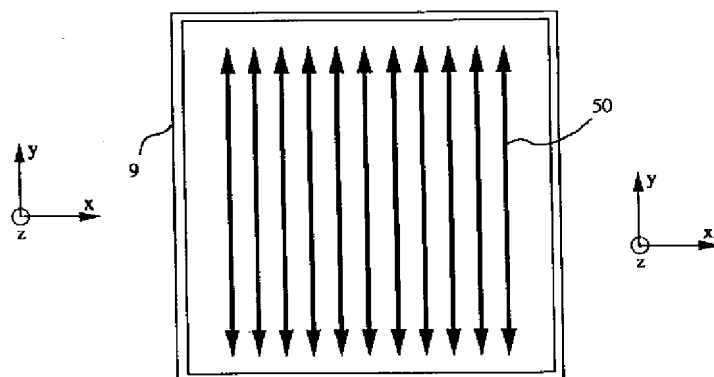
【図12】



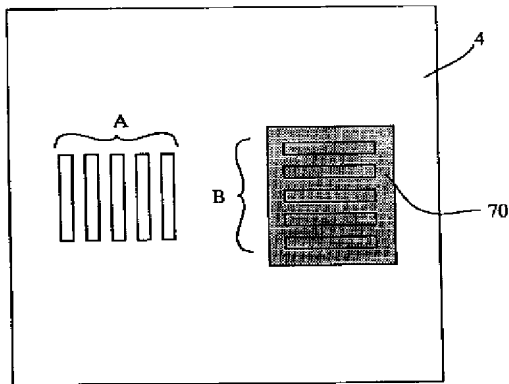
【図13】



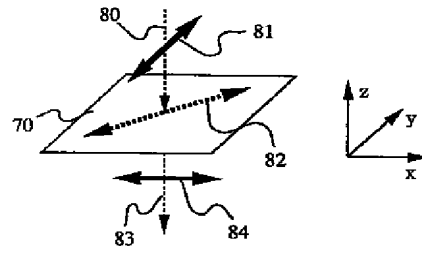
【図14】



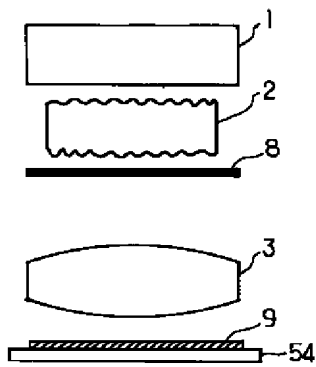
【図17】



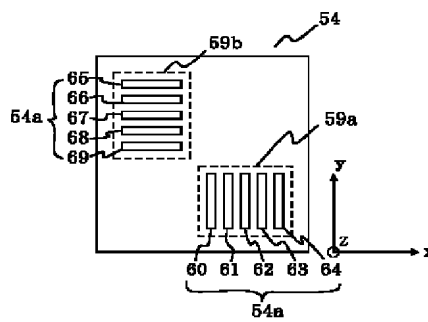
【図18】



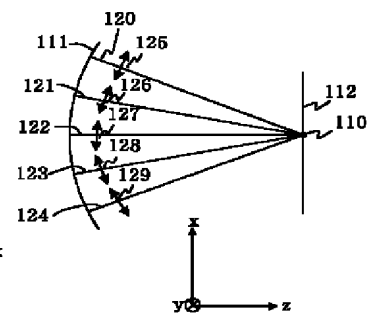
【図20】



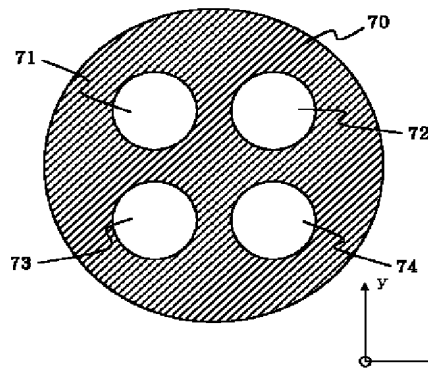
【図21】



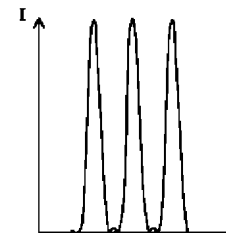
【図27】



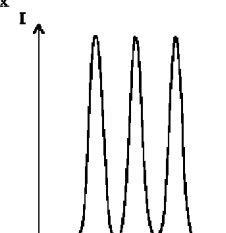
【図22】



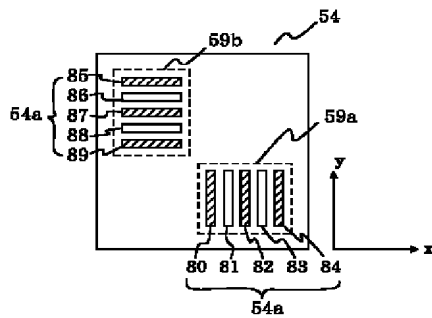
【図28】



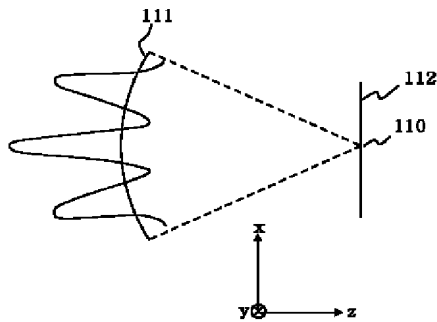
【図29】



【図23】

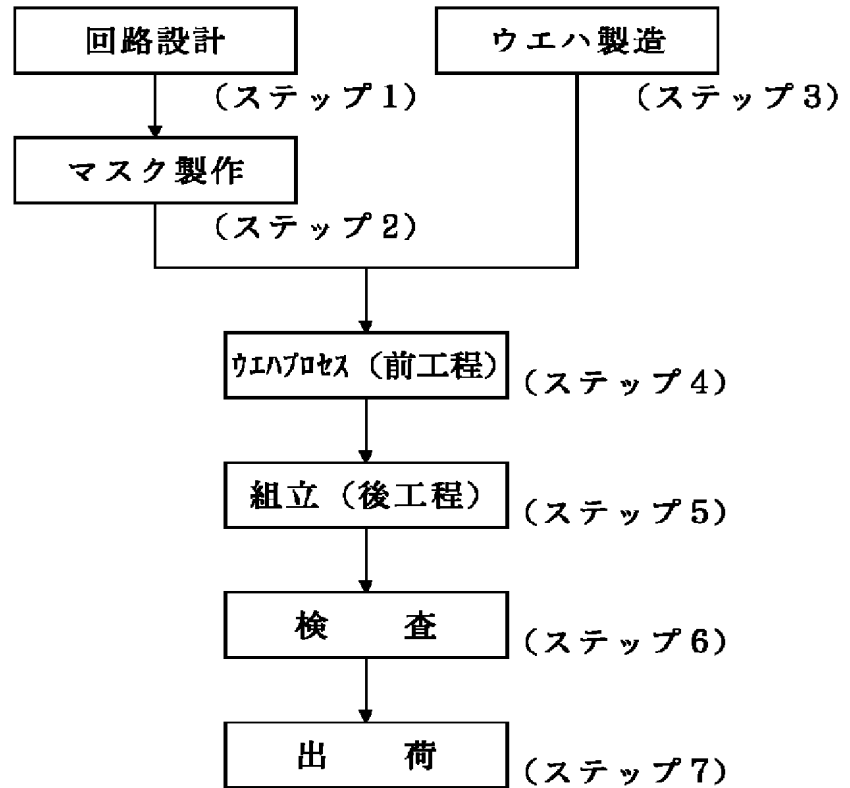


【図26】

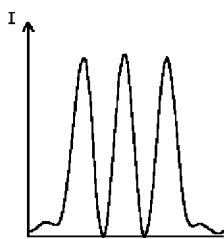


【図24】

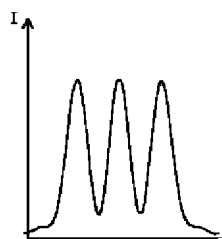
半導体デバイス製造フロー



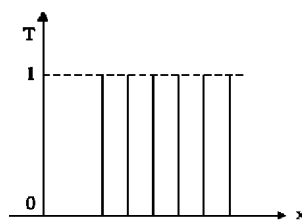
【図30】



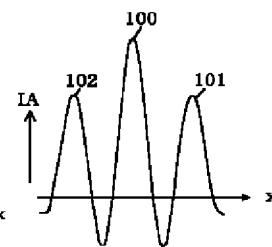
【図31】



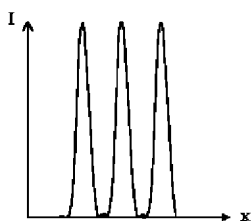
【図32】



【図33】

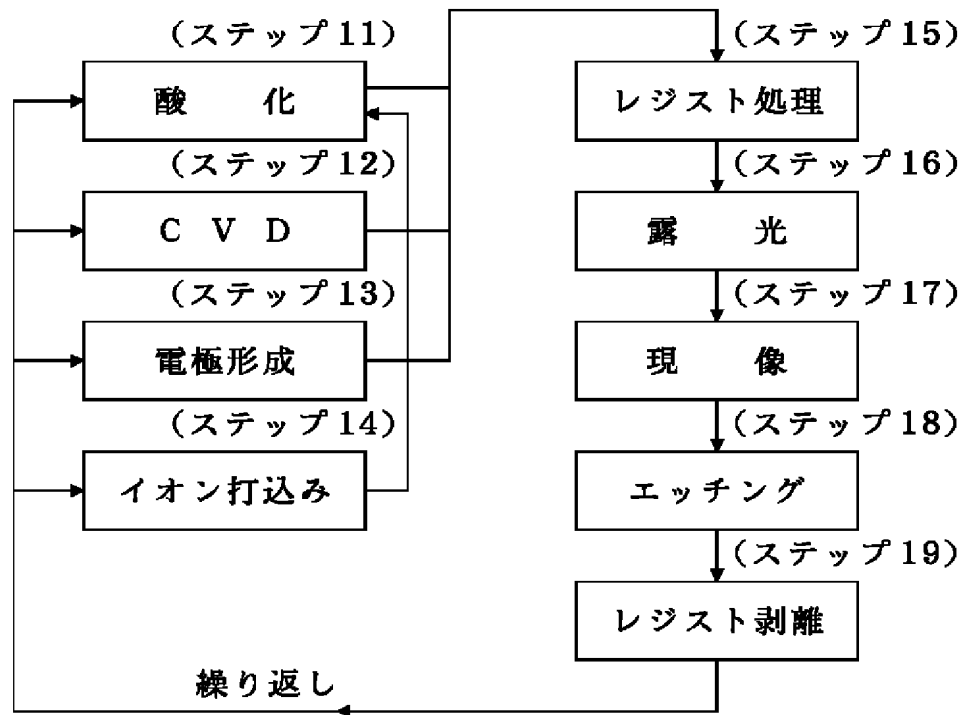


【図34】

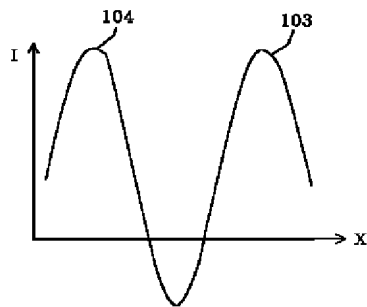


【図25】

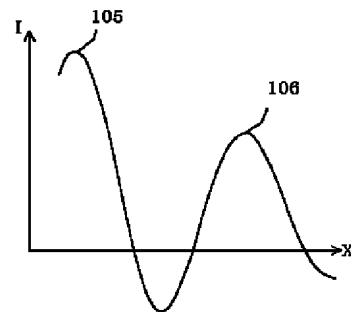
ウエハプロセス



【図35】



【図36】



フロントページの続き

(51)Int. Cl.⁵

G 1 1 B 5/31

識別記号

庁内整理番号

M 8947-5D

F I

技術表示箇所